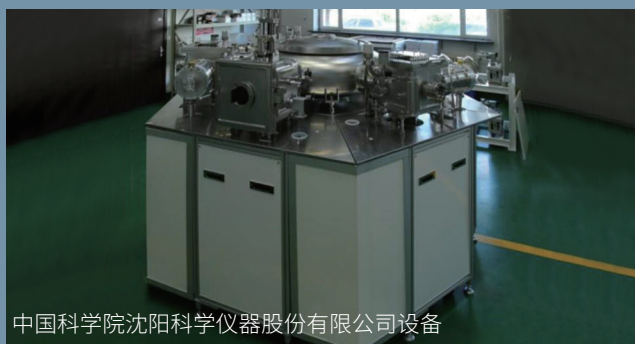


等离子体化学气相沉积镀膜设备

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition Coating Equipment

PECVD-300、PECVD-400



中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司设备

中国科学院微电子研究所设备

性能指标

- 中央传输室极限压力 $\leq 2 \times 10^{-4}$ Pa
- 进出片室极限压力 $\leq 6.67 \times 10^{-1}$ Pa
- 沉积室极限压力 $\leq 2 \times 10^{-6}$ Pa

主要应用

沉积碳化硅、非晶硅和微晶硅薄膜

代表性应用成果

广泛应用于使用 PECVD 方法制备的薄膜研制和太阳能薄膜电池的研制

主要用户单位	辽宁（锦州）光伏研究院、中国科学院物理研究所、斯威本科技大学、广州市中普电子有限公司、上海理工大学、创隆实业（深圳）有限公司等		
研制单位	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、中国科学院微电子研究所		
联系方式	何老师	010-82995592, 13581817539	hemeng@ime.ac.cn
	万向明	024-23826855, 13998191237	wanxm@sky.ac.cn